



RoHS対応品

■特長

- 小型セラミックパッケージタイプ
- シーム封止による高信頼性
- CMOS出力 CL=50pF max.対応
- 電源電圧 Vcc=3.3V

■周波数許容偏差 (Overall)

許容偏差 コード × 10 ⁻⁶	動作温度範囲 (°C)	備考
0 ± 50	-10 ~ +70	標準仕様
S ± 30		対応可能周波数についてはお問い合わせください

■品名表示方法

KC5032C 25.0000 C 3 0 E HL
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名 (5.0×3.2mm SMD)
- ②出力周波数
- ③出力形態 (CMOS/ CL=50pF max.)
- ④電源電圧 (3.3V)
- ⑤周波数許容偏差 (左記表を参照ください)
- ⑥シンメトリ/ INH機能 (45/ 55%、スタンバイ)
- ⑦HL: CL=50pF max. 高負荷対応品

包装形態(テーピング 1000個/ リール)

■規格

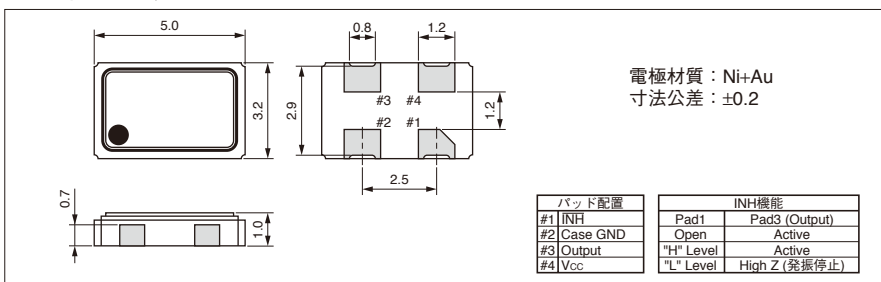
項目	記号	条件	Min.	Max.	単位
出力周波数範囲*	fo		14	30	MHz
周波数許容偏差**	f _{tol}	初期偏差、動作温度範囲内の温度特性、電源電圧変動、負荷容量変動、経年変化(1 year @25°C)、振動・衝撃を含む	-50 -30	+50 +30	×10 ⁻⁶
保存温度範囲	T _{stg}		-55	+125	°C
動作温度範囲	T _{use}		-10	+70	°C
最大定格電圧	—		-0.5	+7	V
電源電圧	V _{CC}	許容偏差コード: 0, S	2.97	3.63	V
消費電流(最大負荷時)	I _{CC}	CL=15pF CL=50pF	—	10 15	mA
スタンバイ時電流	I _{std}		—	10	μA
波形シンメトリ	SYM	@50% V _{CC}	CL=15pF 45 40	55 60	%
立ち上がり/ 立ち下り時間 (10% V _{CC} ~90% V _{CC} 最大負荷時)	tr/ tf	CL=15pF CL=50pF	—	5 8	ns
Lレベル出力電圧	V _{OL}	I _{OL} =8mA	—	10% V _{CC}	V
Hレベル出力電圧	V _{OH}	I _{OH} =-8mA	90% V _{CC}	—	V
出力負荷条件 (CMOS)	L_CMOS	CMOS Output	—	50	pF
入力電圧範囲	V _{IN}		0	V _{CC}	V
Lレベル入力電圧	V _{IL}		—	30% V _{CC}	V
Hレベル入力電圧	V _{IH}		70% V _{CC}	—	V
ディセーブル時間	t _{dis}		—	150	ns
イネーブル時間	t _{ena}		—	5	ms
発振開始時間	t _{str}	最小動作電圧を0 sec.とする	—	10	ms
1Sigma Jitter	J _{Sigma}	Wavecrest DTS-2079 VIS/6.3.1にて測定	—	8	ps
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}		—	80	ps

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。

* レンジ外の周波数については、お問い合わせください。 ** -40~+85°C仕様に関しては、お問い合わせください。

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

